

2.8. Tranzystory przełączające / $t_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$, $t_{stg} = -65^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$ /

Oznaczenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ /						Parametry char							
	U_{CBO}	U_{CEO}	U_{EBO}	I_C	P_{tot}	t_j	h_{21E} przy		U_{CE}	I_C	f_T	C_{CBO} przy	U_{CB}	U_{CE}
	V	V	V	mA	mW	$^{\circ}\text{C}$			V	mA	MHz	pF	V	mV
	max	max	max	max	max	max	min	max			min	max		max
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
BSV 52 ^x BSV 52R ^x	20	12	5	100	200	150	40	120	1	10	400	4	5	40

^x nowe uruchomienia

2.9. Tranzystory dużej mocy wysokonapięciowe

Oznaczenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ /									
	U_{CBO} / U_{CES} /	U_{CEO}	U_{EBO}	I_C	P_{tot} przy / P_C /	t_{case}	t_j	t_{amb}	t_{stg}	
	V	V'	V	A	W	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	
	max	max	max	max	max		max			min
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BU 204 ^x	1300	600	5	2,5	10	90	115	-40 ... +100	-65 ... +115	
BU 205 ^x	1500	700	5	2,5	10	90	115	-40 ... +100	-65 ... +115	
BU 206 ^x	1700	800	5	2,5	10	90	115	-40 ... +100	-65 ... +115	
BU 126 ^x	/750/	300	6	3	30	50	125	-65 ... +125	-65 ... +125	1
BU 326 ^x	/800/	375	6	6	60	50	150	-65 ... +125	-65 ... +150	1
BUP 406 ^x	400	200	6	7	60	25	150			
BUP 407 ^x	330	150	6	7	60	25	150			
BUP 323 ^x	500	350	8	10	175	25	200			15
BUYP 52	120	70	5	5	/50/	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	1
BUYP 53	80	50	5	5	/50/	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	2
BUYP 54	40	30	5	5	/50/	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	2

a układy odchylenia poziomego

b układy zapłonowe

c układy przełączające mocy, stabilizatory, wzmacniacze

d zasilacze impulsowe

BS

etry charakterystyczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C$ /									N n-p-n P p-n-p	Zasto- sowa- nie	Obudo- wa
y	$U_{CE sat}$ przy		t_s przy		t_{on} przy		t_{off} przy				
CB		I_C/I_B		I_C/I_B		I_C/I_B		I_C/I_B			
V	mV	mA	ns	mA	ns	mA	ns	mA			
	max		max		max		max				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	400	50/5	13	10/10	12	10/3	18	10/3	N	układy hybry- dowe	CE 46

BU

Parametry charakterystyczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C$ /							N n-p-n	Zasto- sowanie	Obudo- wa	
h_{21E}		przy		f_T	$U_{CE sat}$ przy					
		I_C	U_{CE}		I_C/I_B					
		A	V	MHz	V	A/A				
min	max			min /typ/	max					
11		12	13	14	15	16	17	18	19	
2,0	60	2	5	/7,5/	5	2/1	N	a	CE 20	
2,0		2	5	/7,5/	5	2/1	N	a	CE 20	
1,8		2	5	/7,5/	5	2/1	N	a	CE 20	
15		1	5	6	10	2,5/0,25	N	d	CE 20	
15		0,6	5	6	10	2,5/0,25	N	d	CE 20	
150	2000			10	1	5/0,5	N	a	CE 30	
				10	1	5/0,5	N	a	CE 30	
		3	6		1,5	3/0,06	N	b	CE 20	
		10	0,5	5	10	0,35	0,5/0,05	N	c	CE 20
		20	0,5	5	10	0,35	0,5/0,05	N	c	CE 20
20		0,5	5	10	0,35	0,5/0,05	N	c	CE 20	

niziacze mocy

x nowe uruchomienia

2.10. Tranzystory dużej mocy wysokonapięciowe specjalne

BU spec

Oznaczenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}/$					Parametry charakterystyczne / $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}/$							N	Zastosowanie	Ubu- do- wa
	U_{CB0}	U_{CE0}	U_{EB0}	I_C	P_C przy t_{case}	t_j	h_{21E} przy I_C	f_T	U_{CE} sat przy						
									I_C	I_C/I_B					
											A	A/A			
V	V	V	A	W	$^{\circ}\text{C}$		MHz	V	max						
max	max	max	max	max	max	max	min	min	max						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BUCP 52	120	70	5	5	50	25	150	10	0,5	10	2	5/0,5	N	układy prze- łączające i wzmocniające mocy, stabiliza- tory	CE 20